志岐成友^{1*}、全伸幸¹、藤井剛¹、浮辺雅宏¹、松林信行¹、小池正記¹、 北島義典²、大久保雅隆¹ ¹産業技術総合研究所,〒305-8568 つくば市梅園 1-1-1 ²KEK,〒305-0801 つくば市大穂 1-1 Shigetomo Shiki¹, Nobuyuki Zen¹, Go Fujii¹, Masahiro Ukibe¹, Nobuyuki Matsubayashi¹,

Masaki Koike¹, Yoshinori Kitajima², Masataka Ohkubo¹ ¹National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 1-1-1 Umezono, Tsukuba, 305- 8568, Japan

²KEK , 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

1 <u>はじめに</u>

蛍光収量法によるX線吸収分光は微量元素の局所 構造を探ることができる数少ない分析手法である。 特に軟X線領域は多種多様な元素の吸収端があるた め重要であり、近年盛んに研究が行われている。

超伝導トンネル接合(STJ; superconducting tunnel junction)検出器は、10 eV 前後の優れたエネルギー分 解能と高い光子計数率を有するため、半導体検出器 で分離分析できない元素の組み合わせに対しても、 STJ 検出器を用いると微量元素の吸収端スペクトル が測定できると期待される。我々は 100 素子 STJ ア レイ検出器を用いた軟X線領域の蛍光収量法による XAFS 測定ステーションを開発し、エネルギー分解 能 10-20 eV、有感面積 1mm²、計数率 500 kcps を実 現し、SiC 中の窒素ドーパント (300ppm)の分析を 可能にした[1]。

本課題では、次の二点についての研究開発を行っ ている。一つは本装置が微量元素の分析に有効であ ることを示すことで、従来分析が不可能とされてき た様々な試料の計測に挑戦している。しかしながら 今年度については、2013 年度末に BL-11A の改修が 行われ、その後フラックス・分解能が不十分となっ たために、進展はない。二つ目は感度および適用可 能な元素の種類を拡大することで、従来 STJ 検出器 が不得意とする1keV以上のX線を検出するため、 シリコンピクセル吸収体を備えた STJ 検出器を開発 している(図1)。2013 年度の準備棟における予備実 験および放射光施設で実施した実験により、試作し た検出器のエネルギー分解能が 5.9 keV のX線に対 して 150 eV FWHM であること、入射方位によりエ ネルギー分解能や P/B 比が変化すること、100 素子 アレイを用いて軽元素 S~KのK吸収端で吸収スペ クトルが測定できることが明らかになった。



図 1. シリコンピクセル吸収体を有する STJ 検出 器の模式図。

本年度はエネルギー分解能を向上させる方法を探 るため、放射光を検出器に直接照射し、直線性、お よび、入射位置による応答の違いを測定した。

2 実験

使用した検出器は昨年度の報告と同じである。厚 さ 400 µm の Si 基板上に 100 µm 角の Nb/Al-STJ を 100 素子作製し、Si 基板に深さ 350 µm の深溝を形成 して STJ 直下に 100 µm 角の吸収体を作成した。こ の構造により、有効面積は 1 mm²,検出効率は 8.5 keV 以下で 99% 以上である。

検出器をビームラインの焦点付近に設置し、3He クライオスタットを用いて 300mK に冷却した。Ioモ ニタ直上の4象限スリットを用いて入射光の強度を 調整した。検出器直前に XY2個のスリットを設置 し、入射光の強度および入射位置を調整した。スリ ットの幅は 30-50 ミクロンで吸収体の大きさ 100 ミ クロンに比べてやや小さい。

3 <u>結果および考察</u>

今回の実験では³He 冷凍機から³He ガスが真空槽 にスローリークするというトラブルがあり、これに よって検出器の特性にゆるやかな時間変化が見られ た。そのため直線性については信頼できるデータが 得られなかった。

図2に吸収体の対角線上をスキャンした時の、波 高スペクトルを示す。吸収体の中心では、波高が高 く、エネルギー分解能もよい。入射位置が中央から 離れるに従い波高値が低下し、分解能も悪化した。 例外として、中央から 50-75 ミクロン離れたところ では、メインピーク以外に中央より波高値が高いイ ベント成分が現れた。中央から 100 ミクロン離れた ところではこのような信号は発生していない。波高 値が高いイベント成分は、溝の底でX線が吸収され た時に生じると考えられる。

吸収体の端において波高の低下が生じ、分解能が 劣化すること、溝の底で吸収されたX線が波高スペ クトルのバックグラウンドとなることが明らかにな った。エネルギー分解能を改善するためには、吸収 体のサイズを拡大し、端の寄与を少なくすることが 有効である。またバックグラウンドを減らすには、 溝へのX線の入射を抑制することが必要となる。そ の為には溝の幅を狭くすること、斜めに入射させる ことやコリメータを利用することが有効である。

4 <u>まとめ</u>

シリコンピクセル吸収体を有する STJ 検出器の特 性を、放射光を直接照射して測定した。X線入射位 置により波高が変化すること、溝の底で吸収された X線がバックグラウンドとなることが明らかになっ た。

謝辞

本研究は所属グループ各位の協力の元で実施され ました。本研究は科研費(25390142)の支援を受けま した。検出器の開発・評価に際し、産総研 CRAVITY, NIMS 微細加工プラットフォーム、産総



研NPFの支援を受けました。

参考文献

[1] S. Shiki et al., J. Low Temp. Phys. 176, 604 (2014)

* s-shiki@aist.go.jp